memtest+mp4

reboot

wakeup/sleep

dc drop

ddr scan

DFS

read disturb <https://www.cnblogs.com/Caden-liu8888/p/7388741.html> 读操作时，衬底加电压是0，读取的page，控制极上的电压是Vref，而对其他Page，控制极上加的电压是Vpass。问题来了，由于其他Page上加了一个Vpass，相对来说是一个比较大的电压，这样就会在浮栅极和衬底形成一个较强的电场，可能就把一些电子吸入浮栅极，有点轻微Program的意思。随着该Block上Page数据读的次数越来越多，无辜的page（没有被读到的）中的浮栅极电子进入越来越多，导致里面数据状态发生变化，也就意味着数据出错。

这就是Read Disturb

io performance

flash test 反复写文件，再删除，再写的测试